

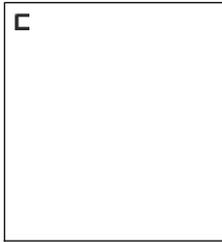


中国科学院半导体研究所
Institute of Semiconductors, CAS



首页 所情概况 两院院士 机构设置 杰出人才 获奖概况 研究生教育 党建与创新文化 信息公开 半导体学报

首页 > 中文 > 专家人才 > 研究生导师



王军喜



王军喜, 男, 博士, 研究员, 博士生导师。

1998年获得西北大学物理学学士学位, 2003年获得中国科学院半导体研究所工学博士学位, 自2003年至今在中国体研究所工作。

从事氮化物材料生长和器件研制工作八年, 熟悉MOCVD、MBE和HVPE生长设备和相关材料分析表征方法; NH₃-MBE生长设备, 获得了具有当时国际水平的高迁移率GaN外延片; 做为骨干科研人员, 所在小组研制成功了压电极化高质量AlGaIn/GaN二维电子气结构材料, 并用所研制的材料与信息产业部第十三研究所合作研制出了我国第一只氮化物器件; 负责自主设计并制备了一台HVPE厚膜GaIn材料生长设备, 获得了厚膜GaIn材料生长速率超过了每小时200μm, 晶体质量位于国内领先水平; “五”期间, 负责氮化物MOCVD材料生长研究, 主要方向为GaIn基LED材料生长研究和紫外LED材料生长研究。

目前负责的课题进展顺利。多次参加国内外学术会议, 在国内外高质量学术期刊上发表研究论文四十余篇。

目前主要研究方向:

氮化物材料的MOCVD生长研究、深紫外LED用氮化物材料生长研究及LED器件制备。

联系方式:

E-mail: jxwang@semi.ac.cn; 电话: 010-82305408

完成/在研主要项目:

- 1、国家“863”项目: “Si基GaIn材料研究”(2004-2005)
- 2、国家自然科学基金项目: “GaIn基气敏传感器材料和器件研究”(2006-2008)
- 3、国家“863”项目: “紫外LED用AlGaIn材料生长研究”(2006-2008)

参与其它科研项目6项。

代表性论文:

1. **J. X. Wang**, D. Z. Sun, X. L. Wang, J. M. Li, Y. P. Zeng, X. Hou, L. Y. Lin, “High-quality GaIn grown by gas-source MBE” *Crystal Growth* 227-228, 386-389 (2001)
2. **Junxi Wang**, Xiaoliang Wang, Dianzhao Sun, Jinmin Li, Yiping Zeng, Guoxin Hu, Hongxin Liu, Lanying Lin, “High-r polarity GaIn achieved by NH₃-MBE”, *MRS Symposium Proceedings Vol 743*, 85-90 (2003)

3. **Junxi Wang**, Jianchang Yan, Naixin Liu, Ping Ma, Zhe Liu, Yiping Zeng, Guohong Wang, Jinmin Li, "AlGaN Grown by N₂ Plasma on High Temperature AlN Layer", The 2nd International Conference on Displays and Solid State Lighting, oral presentation, Jan 30-31, 2007, Beijing, China.



下载视频观看

联系方式
 通信地址
 北京市海淀区清华东路甲35号 北京912信箱 (100083)
 电话
 Dianzhao Sun, Jinmin Li, Yiping Zeng, Hongxin Liu, Fengyi Huang, Lanqing Lin, "GaN grown on SiC substrate by RF-MBE", Journal of Crystal Growth Vol 276, 401-404 (2007)
 E-mail
 semi@semi.ac.cn
 邮编
 100083
 电话
 010-62793366
 传真
 010-62793366
 邮编
 100083

友情链接
 中华人民共和国科学技术部
 中国科学院
 中国工程院
 国家自然科学基金委员会
 中国科学院大学
 中国科学技术大学

6. Hongling Xiao, Xiaoliang Wang, **Junxi Wang**, Nanhong Zhang, Hongxin Liu, Yiping Zeng, Liangliang Zhang, Zhenzhen Wang, "GaN grown on SiC substrate by RF-MBE", Journal of Crystal Growth Vol 276, 401-404 (2007)



备案号: 京ICP备05085259号 京公网安备110402500052 中国科学院半导体所声明



7. wei, TB, Ma, P, Duan, RF, **Wang, JX**, Li, JM, Liu, Z, Zeng, YP, "Cathodoluminescence and Raman research of V-shape pyramid in HVPE grown GaN film", MATERIALS LETTERS, 61 (18)(2007) 3882-3885

8. Wei, TB, Duan, RF, **Wang, JX**, Li, JM, Huo, ZQ, Ma, P, Liu, Z, Zeng, YP, "Characterization of free-standing GaN substrate through hydride vapor phase epitaxy with a TiN interlayer", Applied Surface Science, Vol 253(18), 7423-7428 (2007)